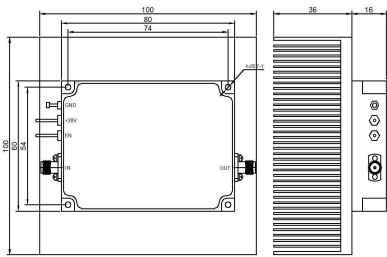


30-1000 MHz GaN RF 전력 증폭기, 전형 10 W

GaN 증폭기는 30-1000 MHz를 지원하며 포화 출력은 최소 9 W, 전형 10 W입니다. 전형 이득은 40 dB, 평탄도는 ± 1 dB이며 10 W 출력 시 전형 전류는 0.6 A입니다.



전기 사양 · +28.0VDC; 25°C; 50Ω

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
동작 주파수	BW	30	-	1000	MHz
RF 출력 전력 @ PSAT	PSAT	9	10	-	W
전력 이득 @ PSAT	Gp	-	40	-	dB
전력 이득 평탄도 @ PSAT	ΔGp	-	± 1	-	dB
입력 반사 손실	S11	-	-15	-	dB
10 W 조건의 고조파	H	-	-12	-	dBc
스퓨리어스 신호 @ PSAT	Spur	-	-60	-	dBc
입출력 임피던스	Impedance	-	50	-	Ω
동작 전압	VDC	-	28	-	VDC
DC 전류 @ 10W	IDD	-	0.6	-	A

절대 최대 정격

항목	정격
손상이 발생하지 않는 RF 입력 전력	+5 dBm 최대
P_{out} = 10 W 조건의 부하 VSWR	5:1; 모든 부하 위상 및 진폭, 연속
열 과부하	85 °C → 정지 (최대)

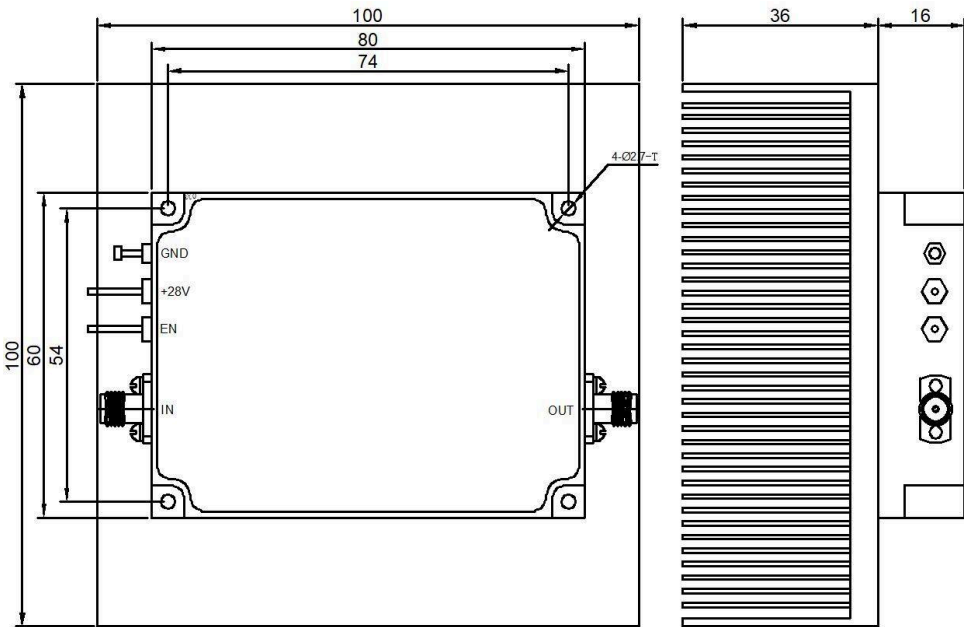
환경 사양 · 설계 목표; 프로젝트별 확인 필요

항목	최솟값	일반값	최댓값	단위	비고
동작 온도	-20	-	50	°C	-
보관 온도	-25	-	65	°C	보관 온도
상대 습도(비응축)	-	-	95	%	-

기구 사양

항목	값	단위
외형 치수	100 × 100 × 52[3.94 × 3.94 × 2.05] mm [in]	mm [in]
중량	2.5 kg (전형값)	kg
RF 입력 커넥터	SMA, 암	-
RF 출력 커넥터	SMA, 암	-
DC/제어 인터페이스	관통 핀	-
접지 커넥터	접지 핀	-

기구 외형도



모든 치수의 단위는 mm [in]입니다.

DC 및 제어 인터페이스

핀 번호	설명	사양
+28V	+28V — 전원 양극	+28 VDC
GND	GND — 접지	접지
EN	EN — 활성화	TTL High 레벨(3.3 V), 내부 풀다운

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.